

АЕЯР.431210.211ТУ

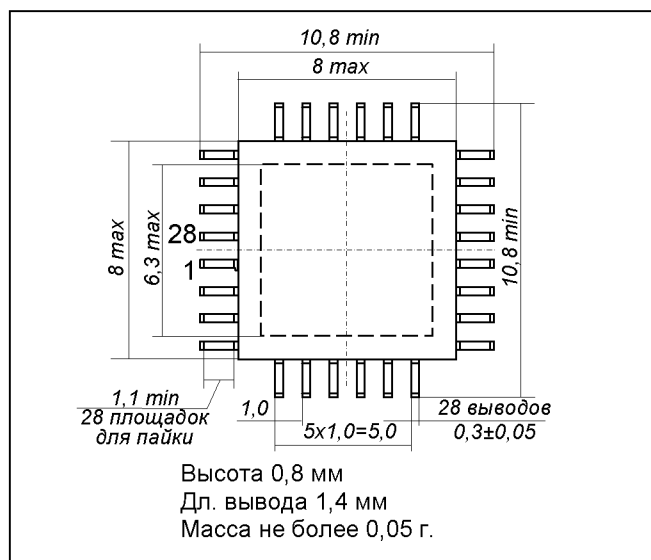
558PP4H2

## 64К (8Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

NМОП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с электрической записью-стиранием информации, в бескорпусном исполнении на гибком носителе с ленточными выводами. Предназначено для построения энергонезависимой памяти микро-ЭВМ, систем промышленной автоматики, связи и измерительной техники. Микросхема устойчива к воздействию спецфакторов по группе 1У.

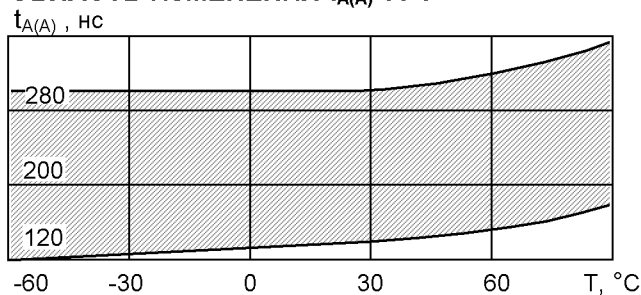
- время выборки адреса 400нс;
- напряжение питания  $U_{CC} = 5В \pm 10\%$ ;
- напряжение программирования  $16В \pm 0,5В$ ;
- допустимое значение статического потенциала не более 100В;
- поставка микросхем осуществляется в индивидуальной таре-спутнике ЛАРС.431434.003.



### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	$t_{и}$	100 000
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	25

### ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ ОТ T



### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1	$U_{PR}$	Напряжение программирования
2 - 10, 21, 23 - 25	A0 - A12	Вход адресный
11 - 13, 15 - 19	D0 - D7	Вход-выход
20	CE	Вход сигнала разрешения обращения
14	OV	Общий
22	OE	Вход сигнала разрешения выхода OE
26	-	Свободный
27	WR/RD	Вход сигнала записи-считывания
28	$U_{CC}$	Источник питания

### ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ

Механические удары, g	1500
Линейное ускорение, g	20 000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, g	40
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °C	от - 60 до 125
Повышенная влажность при T = 35 °C, %	до 98
Температура пайки, °C	235 ± 5
Продолжительность, с	2 ± 0,5

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ( $U_{CC} = 5 В \pm 10\%$ )

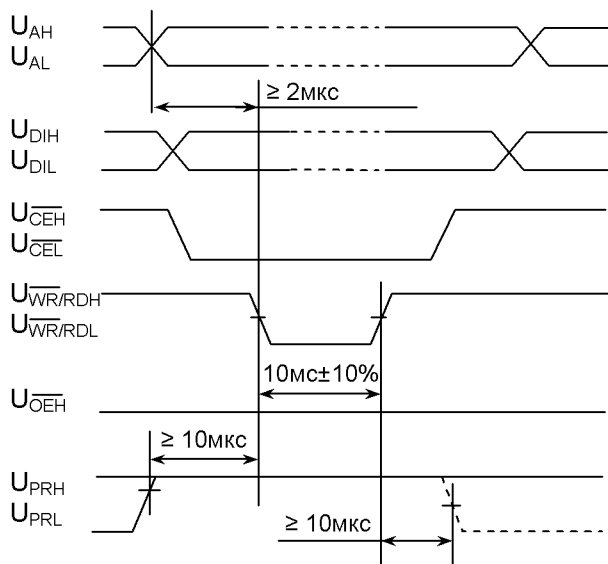
Символ	Параметр	T, °C	558PP4H2
$U_{DOL}$	Выходное напряжение низкого уровня сигнала выходной информации, В ( $I_{OL} = 1,6 \text{ mA}$ )	от - 60 до 85	$\leq 0,4$
$U_{DOH}$	Выходное напряжение высокого уровня сигнала выходной информации, В ( $I_{OH} = 0,1 \text{ mA}$ )	от - 60 до 85	$\geq 2,4$
$I_{CC}$	Ток потребления, мА	от 25 до 85 -60	$\leq 60$ $\leq 80$
$I_{LI(A)}$	Ток утечки на входах и выходах, мкА	от - 60 до 85	$\leq 10$
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	$25 \pm 10$ - 60, 85	$\leq 0,35$ $\leq 0,4$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	$25 \pm 10$ - 60, 85	$\leq 0,35$ $\leq 0,4$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	$25 \pm 10$ - 60, 85	$\leq 0,15$ $\leq 0,2$
$t_{SG1}^*$	Время хранения информации при отключённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 25\ 000$
$t_{SG2}^*$	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 15\ 000$
$N_{CY}^{**}$	Количество циклов перепрограммирования, цикл	от - 60 до 85	$\geq 10\ 000$

\* При количестве циклов перепрограммирования от 1 до  $10^3$  время хранения информации при отключённом питании  $t_{SG1}$  не менее 87 600 ч. (10 лет).

\*\* При количестве циклов перепрограммирования от 1 до  $10^3$  в диапазоне рабочих температур среды от минус 60 °C до 85°C время хранения информации при включённом питании  $t_{SG2}$  не менее 25000 ч.

\*\*\* Уровень дефектности при перезаписи информации после  $10^3$  циклов не превышает 2,5%.

**ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ**



Длительность сигнала записи стирания:

- при стирании  $100 \text{ мс} \pm 10\%$ ;
- при записи  $10 \text{ мс} \pm 10\%$ .